

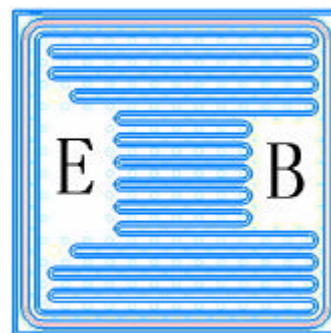


BU406 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C270AG-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：2700×2700μm²
 焊位尺寸：B 极 550×900μm²；E 极 550×1100μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：BU406，BU406H

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

T _{stg}	—贮存温度.....	-55~150
T _j	—结温.....	150
P _C	—集电极功率耗散 (T _c =25)	60W
V _{CBO}	—集电极—基极电压.....	400V
V _{CEO}	—集电极—发射极电压.....	200V
V _{EBO}	—发射极—基极电压.....	6V
I _C	—集电极电流 (DC)	7A
I _{CP}	—集电极电流 (脉冲)	10A
I _B	—基极电流.....	4A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	200			V	I _C =10mA, I _B =0
I _{CES}	集电极—发射极截止电流			5	mA	V _{CE} =400V, V _{BE} =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V _{EB} =6V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	12				V _{CE} =1V, I _C =1A
		5				V _{CE} =1V, I _C =5A
		30				V _{CE} =5V, I _C =2A
		8				V _{CE} =5V, I _C =5A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1	V	I _C =5A, I _B =0.5A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1	V	I _C =5A, I _B =0.8A
				1.2	V	I _C =5A, I _B =0.5A
f _T	特征频率	10		1.2	V	I _C =5A, I _B =0.8A
t _{OFF}	下降时间			0.75	? s	I _C =5A, I _B =0.5A